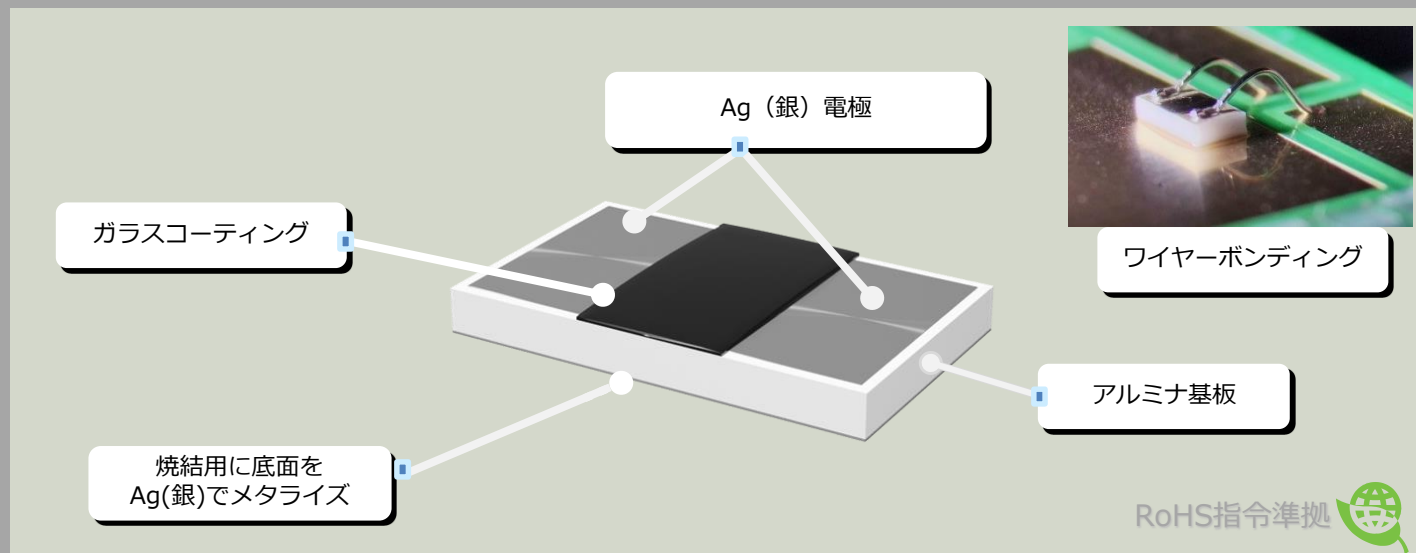




200℃対応 SiC/GaN用 ワイヤーボンド厚膜チップサーミスタ



RoHS指令準拠



特徴

- SiC・GaNの高温動作に対応したチップタイプの角形チップNTCサーミスタです。
- アルミナ基板上にサーミスタ膜を形成、ガラスで保護した構造で高い機械強度と信頼性が得られます。
- 焼結やシンタリングのため底面はAg（銀）をメタライズしています。
- 抵抗値に関係なく厚さが一定のため、実装基板の薄型化に貢献します。
- 独自の調合法により、お客様のご要望に合わせた抵抗値とB定数に調整することができます。
- 熱応答性が高く、熱容量が小さいため、温度変化に対して迅速に反応します。
- AEC-Q200にも対応可能です。
- ギ酸リフローに対応可能です。

アプリケーション

- SiC / GaN パワーモジュール
- EV / HEV 向けインバーター
- IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) の温度補償
- MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) の温度補償
- DC-DC コンバーター
- OBC (On-Board Charger) の温度管理
- 半導体、電子部品の温度補償
- ABS制御回路

製品の特性はお客様のご要望に応じてカスタマイズが可能です。

仕様

サイズ	使用温度範囲	抵抗値(25℃)	抵抗値許容差	B定数 (25℃/85℃)	B定数許容差	熱放散定数 (気中)	最大許容電力	定格電力 (25℃)	包装数量 Q'ty
2012mm (0805寸法)	-50℃ ~ +200℃	1K ~ 500kΩ	±1%, ±2%, ±3%, ±5%, ±10%	3375~4500K	±1%, ±2%, ±3%, ±5%	δ≤1.5mW/℃	5mW	130mW	5000pcs

※他の性能や形状については問い合わせください。

